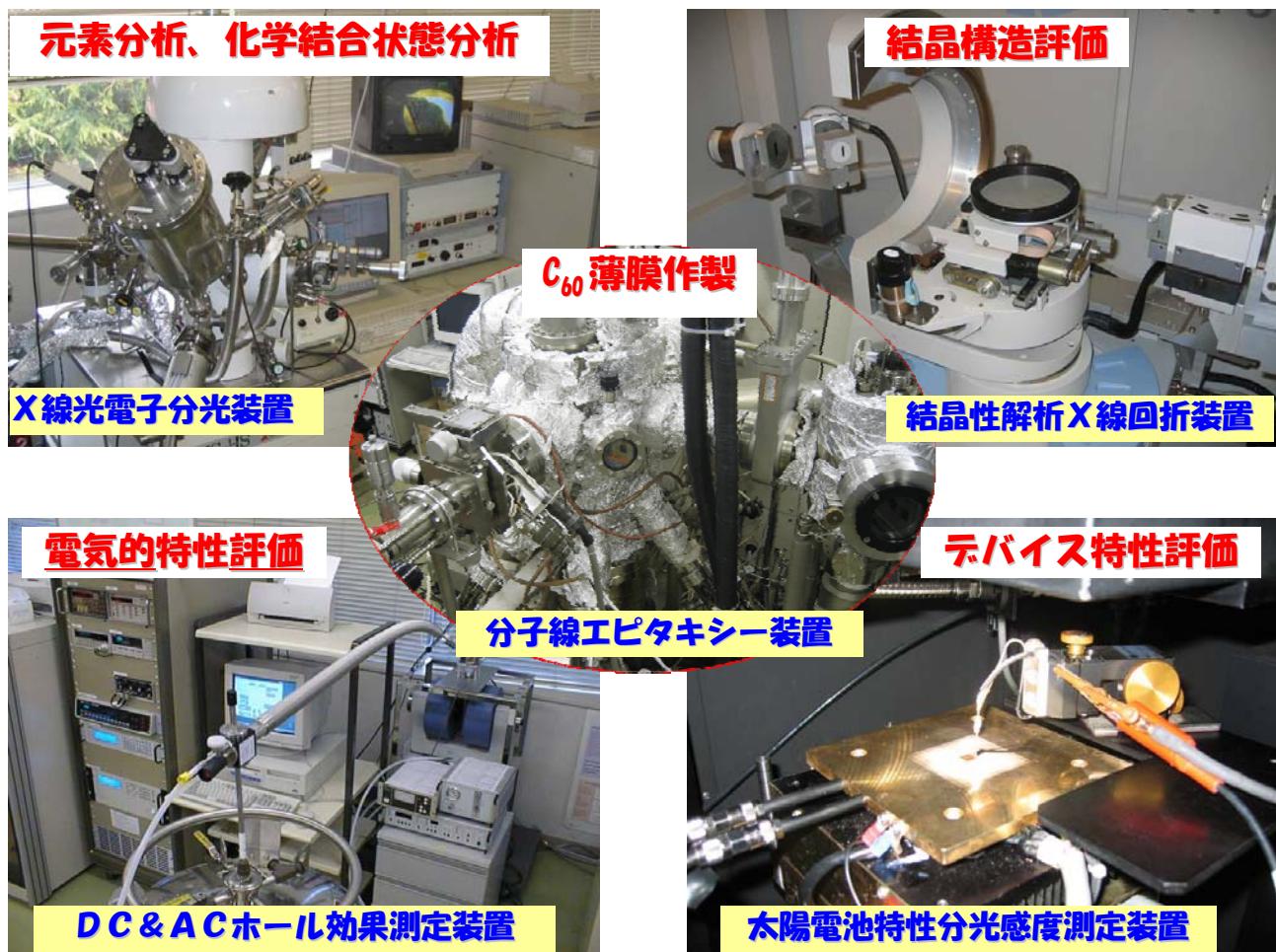


化合物半導体デバイス構造・シリコン・ フラーレンナノ構造の作製と評価支援

やまぐち まさふみ
豊田工業大学 山口 真史 特任教授
おおした よしお
大下 祥雄 准教授
こじま のぶあき
小島 信晃 助教

分子線エピタキシー装置によるC₆₀（エピタキシャル）薄膜の作製支援、ならびに化合物半導体、シリコン、フラーレン等半導体ナノ構造の物性評価支援を行う。物性評価支援では、以下の装置が利用できる。
①X線光電子分光装置：元素分析、化学結合状態分析。（空間マッピング測定可能）、
②結晶性解析X線回折装置：結晶構造評価。（ロッキングカーブ測定、逆格子空間マッピング測定、極点図解析等）、
③DC & ACホール効果測定装置：電気的特性（キャリア濃度、移動度）評価。（測定温度4~400K）、
④太陽電池特性分光感度測定装置：太陽電池デバイス評価、光導電率測定。



関連業績

- 1) “Influence of surface steps on N incorporation in GaAsN grown by chemical beam epitaxy”, K. Nishimura, H. S. Lee, H. Suzuki, T. Kawahigashi, T. Imai, K. Saito, Y. Ohshita, M. Yamaguchi, Physica Status Solidi C, 3, p. 2689, (2006).
- 2) “Optical properties of C₆₀/a-C superlattice structures for solar cell applications”, N. Kojima, Y. Sugiura, M. Yamaguchi, Solar Energy Materials & Solar Cells, 90, p. 3394, (2006).
- 3) “Antireflective Subwavelength Structures on Crystalline Si Fabricated Using Directly Formed Anodic Porous Alumina Masks”, H. Sai, H. Fujii, K. Arafune, Y. Ohshita, M. Yamaguchi, Y. Kanamori, H. Yugami, Appl. Phys. Lett., 88, p. 201116, (2006).
- 4) “Study on Iron Distribution and Electrical Activities at Grain

- 5) “Boundaries in Polycrystalline Silicon Substrate for Solar Cells”, K. Arafune, E.. Ohishi, H. Sai, Y. Terada, Y. Ohshita, M. Yamaguchi, Jpn. J. Appl. Phys., 45, p. 6153, (2006).
- 6) “Effects of Thermal Cycle Annealing on Reduction of Defect Density in Lattice-Mismatched InGaAs Solar Cells”, T. Sasaki, K. Arafune, H.S. Lee, N.J. Ekins-Daukes, S. Tanaka, Y. Ohshita, M. Yamaguchi, PhysicaB, 376-377, p. 626, (2006).
- 7) “Super High Efficiency Multi-Junction and Concentrator Solar Cells”, M. Yamaguchi, T. Takamoto, K. Araki, Solar Energy Materials & Solar Cells, 90, p. 3068, (2006).
- 8) “Chemical Beam Epitaxy of InGaAsN Films for Multi-Junction Tandem Solar Cells”, H.S. Lee, K. Nishimura, Y. Yagi, M. Tachibana, N.J. Ekins-Daukes, Y. Ohshita, N. Kojima, M. Yamaguchi, J. Cryst. Growth, 275, p. e1127, (2005).